

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Takahiro INOUE
SERIAL NO: NEW APPLICATION
FILED: HEREWITH
FOR: SEMICONDUCTOR APPARATUS

GAU:
EXAMINER:

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):
Application No. Date Filed
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2003-278228	July 23, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
☐ are submitted herewith
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 2 3 日
Date of Application:

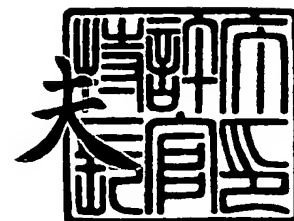
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 2 7 8 2 2 8
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 2 7 8 2 2 8]

出 願 人 三 菱 電 機 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 3 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 546194JP01
【提出日】 平成15年 7月23日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H03K 17/04
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 三菱電機株式会社内
 【氏名】 井上 貴公
【特許出願人】
 【識別番号】 000006013
 【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号
 【氏名又は名称】 三菱電機株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100086405
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 河宮 治
 【電話番号】 06-6949-1261
 【ファクシミリ番号】 06-6949-0361
【選任した代理人】
 【識別番号】 100098280
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 石野 正弘
 【電話番号】 06-6949-1261
 【ファクシミリ番号】 06-6949-0361
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 163028
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

MOS系デバイスのゲートオン時にゲート電流を供給する第1のスイッチと、ゲートオフ時にゲート容量の電荷を放電する第2のスイッチとを有する半導体装置において、

前記ゲート電流を増大させるための第3のスイッチと、前記第1のスイッチのオン時に、前記第3のスイッチオンにし、このスイッチオンから第1の所定の時間後に第3のスイッチをオフにする第1のタイマー手段と、前記放電時の放電電流を増大させるための第4のスイッチと、前記第2のスイッチのオン時に、前記第4のスイッチオンにし、このスイッチオンから第2の所定の時間後に第4のスイッチをオフにする第2のタイマー手段とを備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

前記1のスイッチおよび第3のスイッチからなるゲートオン用回路とは別に第2のゲートオン回路を備えると共に、前記MOS系デバイスのコレクタ電流を検出する手段を備え、前記コレクタ電流が所定値未満の場合は、前記ゲートオン用回路のみをアクティブとし、前記コレクタ電流が所定値以上の時は、第2のゲートオン回路をもアクティブにしてゲート電流を増大させる請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記MOS系デバイスのターンオン時のコレクタ電流が所定値以上の時、前記MOS系デバイスが次にターンオンする次サイクルにて、第2のゲートオン回路をアクティブにする請求項2に記載の半導体装置。

【請求項 4】

前記第1の所定の時間は、前記第1のスイッチおよび第3のスイッチのオンにより、前記MOS系デバイスがターンオンするに十分な時間であり、前記第2の所定の時間は、前記第2のスイッチおよび第4のスイッチのオンにより、前記MOS系デバイスがターンオフするに十分な時間である請求項1～3のいずれかに記載の半導体装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】半導体装置

【技術分野】

【0001】

この発明は、MOS系デバイスによる半導体装置において、外部より信号を受けて実際にデバイス自体が動作するまでの時間を制御することにより、応答性向上による効率の改善、EMIノイズの低減および損失の低減を目的としたものである。

【背景技術】

【0002】

外部信号によって駆動される終段のMOS系デバイスにおいては、オフの外部信号を受けてから、デバイスが実際にオフ状態になるまでの遅れ時間が大きい。これは、デバイスのゲート回りの容量に起因するものである。従来、ゲートのオン、オフについてはゲートに直列に挿入した抵抗を調節して、ゲートのチャージおよびディスチャージを適正にしていた。即ち、ゲート電圧の立上がり及び立下り時間を、ゲート容量Cとゲート抵抗Rで決まるCR時定数に基づき決定していた。

【0003】

デバイス自身の電流が流れ始めと、電流の切れ始めのタイミングは、デバイス固有のしきい値電圧によるものである。特にデバイスのオフ時のスイッチングは、デバイス固有の速度に関係する。従って、ある値のゲート抵抗のみによって、デバイスのゲートチャージ時間及びディスチャージ時間を規定することは、デバイスのしきい値電圧により生じる遅延時間とは別の遅延時間が新たに生じることになり、効率を低下させてしまう。

【0004】

また、固定のゲート抵抗にてゲートのチャージ及びディスチャージを行うと、ターンオン時のスイッチング速度が低電流領域では定格電流時に比べ速くなる。その為、デバイスに並列接続されているフリーホイールダイオード(FWDi)のターンオン時の dV/dt が大きくなり、EMIノイズ悪化の要因となっている。

【0005】

更に、EMIノイズの低減のためにターンオン時のスイッチング速度を遅くすれば、スイッチング時の損失が大きくなり、このようにノイズ発生とスイッチング時の損失とはトレードオフの関係があり、従来は、双方で納得できるようなポイントを定め、それに対応してゲート抵抗の値を選択していた。

【0006】

そこで低損失で低ノイズな駆動を可能とするために、IGBTのゲートを駆動するスイッチにオン抵抗の異なる複数のMOSFETを用い、これらのスイッチを順次組合せてオン抵抗を過渡的に変化させて駆動能力を変えるようにしたものがある(例えば特許文献1参照)。

【0007】

また、低ノイズ化のために、IGBTのコレクタ検出電流における di/dt を指令値とコンパレータで比較し、その比較結果に基づき、スイッチをオンオフさせてゲート抵抗値を瞬時に変化させるものがある(例えば特許文献2)。

【0008】

【特許文献1】特開2001-223571号「電圧駆動型半導体素子のゲート駆動装置」([0005]、図2)

【特許文献2】特開平10-150764号「電力変換器におけるゲート駆動回路」([0008]、図6)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

特許文献1のものは、ゲート電圧を制御するタイプのものであり、また、多数のスイッチが必要であり、それらのスイッチをIGBTの特性に応じて順次スイッチオンさせるた

めの複雑な制御を必要とした。

【0010】

特許文献2において、コンパレータの比較基準値付近のコレクタ電流が流れているオン動作中にゲート抵抗値を急変させると、IGBTの動作が不安定となり、出力電流が発振することもある。

【0011】

この発明は、応答性向上による効率の向上、EMIノイズの低減および損失の低減を図りつつ、比較的簡単な回路で安定動作の半導体装置を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

【0012】

半導体装置に含まれるIGBTのごときMOS系デバイスは、ゲートオンのために、ゲート電流を供給する第1のスイッチと、ゲートオフのために、ゲート容量の電荷を放電する第2のスイッチとを有する。本発明の半導体装置では、そのゲートオン時に流すゲート電流を増大させるために第3のスイッチを備え、そして、前記第1のスイッチのオン時に、前記第3のスイッチオンにし、このスイッチオンから第1の所定の時間後に第3のスイッチをオフにする第1のタイマー手段とを備える。また、ゲートオフ時に流す放電電流を増大させるために第4のスイッチを備え、そして、前記第2のスイッチのオン時に、前記第4のスイッチオンにし、このスイッチオンから第2の所定の時間後に第4のスイッチをオフにする第2のタイマー手段とを備える。

【発明の効果】

【0013】

この発明によれば、ゲートオンするために、第1のスイッチをオンにすると共に、第3のスイッチを所定の時間オンとして、ゲート電流を第1の所定の時間のみ増大させるようにしたので、ゲートがターンオンするまでの時間を短くでき、また、ゲートオフするために、第2のスイッチをオンにすると共に、第4のスイッチを第2の所定の時間オンにして、ゲートの放電電流を所定の時間のみ増大させるようにしたので、ゲートがターンオフするまでの時間を短縮できる。この構成により、デバイスの損失を低減でき、遅延時間も短縮できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

実施の形態1.

図1は、本発明の実施の形態1における半導体装置における終段のMOS系パワー素子とその駆動系を示した回路を示す。フリーホイールダイオードDが付加されたパワー素子(例えばIGBT)1のゲートをターンオンするために、電源VDDとゲートの間にトランジスタによるスイッチSWon1、SWon2(上記第1および第3スイッチに対応)が直列にして挿入される。スイッチSWon2に対しては定電流素子4が並列に接続される。

【0015】

そして、ゲートをターンオフするために、ゲートとエミッタとの間に、定電流素子5を介して、トランジスタからなるスイッチSWoff1(上記第2スイッチに対応)が接続され、更に定電流素子7を介してスイッチSWoff2(上記第4スイッチに対応)が接続されている。

【0016】

コンパレータ9の「+」入力部には、入力信号VINが入力される共にプルアップ抵抗10が接続されている。そして「-」入力部には、基準電圧源11が接続されている。そのコンパレータ9の出力信号は、インバータ12を介してアンプ13の入力部に供給される。そのアンプ13の非反転出力は、ターンオン信号として、前記スイッチSWon1に供給されると共にタイマー14に入力される。このタイマー14(上記第1のタイマー手段に対応)は、そのターンオン信号の入力があると、前記スイッチSWon2をオンにし、そのスイッチオンから100ns後にそのスイッチSWon2をオフにする。

【0017】

また、前記アンプ13の反転出力は、ターンオフ信号として、前記スイッチSWoff1に供給されると共にタイマー15に入力される。このタイマー15(上記第2のタイマー手段に対応)は、そのターンオフ信号の入力があると、前記スイッチSWoff2をオンにし、そのスイッチオンから200ns後にそのスイッチSWoff2をオフにする。

【0018】

上述した回路の動作を図2のタイムチャートを参照して説明する。外部からの入力信号VINが、ハイレベルのオフ信号(IGBT1をターンオフする信号)からローレベルのオン信号(IGBT1をターンオンする信号)に切り替る過程で、入力オンしきい値(ここでは1.5V)に達すると(時点T1)、スイッチSWon1およびタイマー14を介してスイッチSWon2がオンになる。この時点T1では、スイッチSWoff1はオン(後の説明でわかるように入力信号VINがオフの時はオンになっている)からオフになり、スイッチSWoff2はオフのままである。

【0019】

従って、時点T1にてオンになったスイッチSWon1、スイッチSWon2を通じて、ゲート電流Igが流れ、ゲートチャージが開始される。このとき両スイッチSWon1、SWon2のオンにより、大きなゲート電流Igが流れるため、ゲート電圧がゲートのオンしきい値に達するまでの時間は短く、従って、IGBT1は、スイッチSWon1、SWon2のオン(時点T1)から短時間でターンオンする。

【0020】

スイッチSWon1およびSWon2のオン(時点T1)から100ns後にスイッチSWon2のみがオフになるため、ゲート電流Igはほぼ半分程度に減少するが、IGBT1のスイッチオンを維持するに十分な値である。この100nsの時間は、スイッチSWon1、SWon2のオンからIGBT1がスイッチオンするまでの遅延時間よりも長い目の時間として設定したものである。

【0021】

次に、前記入力信号VINが、ローレベルのオン信号からハイレベルのオフ信号に切り替る過程で、入力オフしきい値(ここでは2.0V)に達すると(時点T2)、スイッチSWon1はオフになる(スイッチSWon2はオフのまま)。一方、時点T2にて、スイッチSWoff1およびタイマー15を介してSWoff2がオンになる。

【0022】

ゲートは、電源Vccから切離されると同時に、スイッチSWoff1、SWoff2ccを通じてエミッタに接続されるため、ゲートディスチャージ(図2では負の電流)が開始される。このとき両スイッチSWoff1、SWoff2のオンにより、大きな放電電流が流れるため、ゲート電圧がゲートのオフしきいに低下するまでの時間は短く、従って、IGBT1は、スイッチSWoff1、SWoff2のオン(時点T2)から短時間でターンオフする。

【0023】

スイッチSWoff1およびSWoff2のオン(時点T2)から200ns後にスイッチSWoff2のみがオフになるため、ゲート放電電流はほぼ半分程度に減少するが、IGBT1のスイッチオフを維持するに十分な値である。この200nsの時間は、スイッチSWoff1、SWoff2のオンからIGBT1がスイッチオフするまでの遅延時間よりも長い目の時間として設定したものである。

【0024】

このようにIGBT1に対するゲートチャージおよびゲートディスチャージ電流を変化させることで、外部入力信号からデバイスの動作完了までの時間を短縮して効率を上げることができる。更に、スイッチング時間(遅延時間)を短縮することで損失を低減できる。

【0025】

尚、図1では、スイッチSWon1とSWon2とを直列にして設けたが、両スイッチを並列に接続し、スイッチSWon2のスイッチオンによりゲート電流Igが増大するようにしてもよい。

【0026】

実施の形態 2.

実施の形態 2 では、ターンオン時の IGBT に流れた電流の大きさに応じて、その IGBT が次にターンオンする次サイクルでゲートのチャージ電流を切り替えてターンオン時のスイッチング速度を切り替えるようにしたものであり、その回路構成を図 3 に示す。

【0027】

図 3 の回路において、図 1 と同一の部品については同じ参照番号を付している。この図 3 では、スイッチ S Won1、S Won2、定電流素子 4、タイマー 14 からなるターンオン用回路とは別に、第 2 のターンオン用回路として、スイッチ S Won3、S Won4、定電流素子 21、タイマー 22 を別途追加している。そしてこの第 2 のターンオン回路を制御するために以下の回路が付加されている。

【0028】

IGBT 1 は、コレクタ電流 I_c の検出用として第 2 のエミッタを備え、その第 2 のエミッタ回路に直列に挿入した抵抗 23 の発生電圧は、コンパレータ 24 の「+」入力部に入力される。このコンパレータ 24 の「-」入力部には基準電圧源 25 が接続され、このコンパレータ 24 の出力は、ラッチ回路 26 の D 端子に入力され、そのラッチ回路 26 の Q 端子よりの出力は更に別のラッチ回路 27 の D 端子に入力される。そして前記コンパレータ 9 の出力は、桁上げ信号として、ラッチ回路 26 の C 端子に入力されると共にインバータ 28 を通じてラッチ回路 27 の C 端子に入力される。

【0029】

ラッチ回路 27 の Q 端子よりの出力は、アンドゲート 29 の一方の入力部に供給され、他方の入力部には、前記アンプ 13 の非反転出力が入力される。そして、そのアンドゲート 29 の出力が、前記スイッチ S Won3 およびタイマー 22 に駆動信号として供給される。

【0030】

上述した回路の動作を図 4 のタイムチャートを参照して説明する。(N-1)パルス目の入力信号 V_{IN} が、ローレベルのオン信号のときにターンオンした IGBT 1 に流れているコレクタ電流 I_c が定格電流の $1/2$ を超えているか否かがコンパレータ 24 によって判定されておりその判定結果がラッチ回路 26 に供給されている。

【0031】

この(N-1)パルス目の入力信号 V_{IN} において、ローレベルからハイレベルのオフ信号(IGBT 1 をターンオフする信号)に切り替る過程で、入力オフしきい値を超えると(時点 T3)、コンパレータ 9 からハイレベルが出力される。これにより、ラッチ回路 26 でラッチしていた信号がラッチ回路 27 に供給される。

【0032】

次に、入力信号 V_{IN} が、ハイレベルのオフ信号からローレベルのオン信号に切り替る過程で、入力オンしきい値を下回って、(n-1)パルス目から n パルス目に移行する時(時点 T4)、スイッチ S Won1、S Won2 がオンになるが、このとき、前記の時点 T3 でコレクタ電流 I_c が定格電流の 50% 以上の場合には、ラッチ回路 27 よりアンドゲート 29 にハイレベルが供給されることにより、スイッチ S Won3、S Won4 もオンとなる。

【0033】

このように全スイッチ S Won1~S Won4 がオンになったときは、ゲート電流 I_g は、予め設定した値の 100% となり、そのゲート電流 I_g で IGBT 1 がスイッチオンされる。この時点 T4 から 100 ns 後にタイマー 14、22 によって、スイッチ S Won2、S Won4 がオフとなるので、ゲート電流 I_g は 50% の出力に低下する。

【0034】

一方、時点 T3 でコレクタ電流 I_c が定格の 50% 未満であった場合は、時点 T4 でアンドゲート 29 はローレベルを出力したままとなっているため、スイッチ S Won1、S Won2 のみがオンとなり、ゲート電流 I_g は 50% の出力となる。この場合の動作は図 1 の場合と同じになる。

【0035】

以上説明した動作のように、IGBT1の高電流動作(定格電流の50%以上)では、ゲート電流 I_g を大きくしてIGBT1のスイッチング速度を速くしているため、従来のような固定のゲート抵抗を使用しているものに比べスイッチング時の損失を低減できる。一方、IGBT1の低電流動作(定格電流の50%未満)では、ゲート電流 I_g を小さくしてスイッチング速度を遅くすることで、フリーホイールダイオードDのターンオフ時の dV/dt も小さくなり、EMIノイズの低減に効果がある。

【0036】

又、IGBT1の高電流動作が検出された時、ゲート電流 I_g を直ちに大きくするのではなく、IGBT1が次にターンオンする次サイクルにて行うようにしているため、特許文献2で述べたように、IGBT1の動作が不安定になって出力電流が発振するといった不具合をなくせる。

【図面の簡単な説明】

【0037】

【図1】実施の形態1を示した半導体装置の主要部を示した回路図

【図2】図1の回路の動作を示したタイムチャート

【図3】実施の形態2を示した半導体装置の主要部を示した回路図

【図4】図3の回路の動作を示したタイムチャート

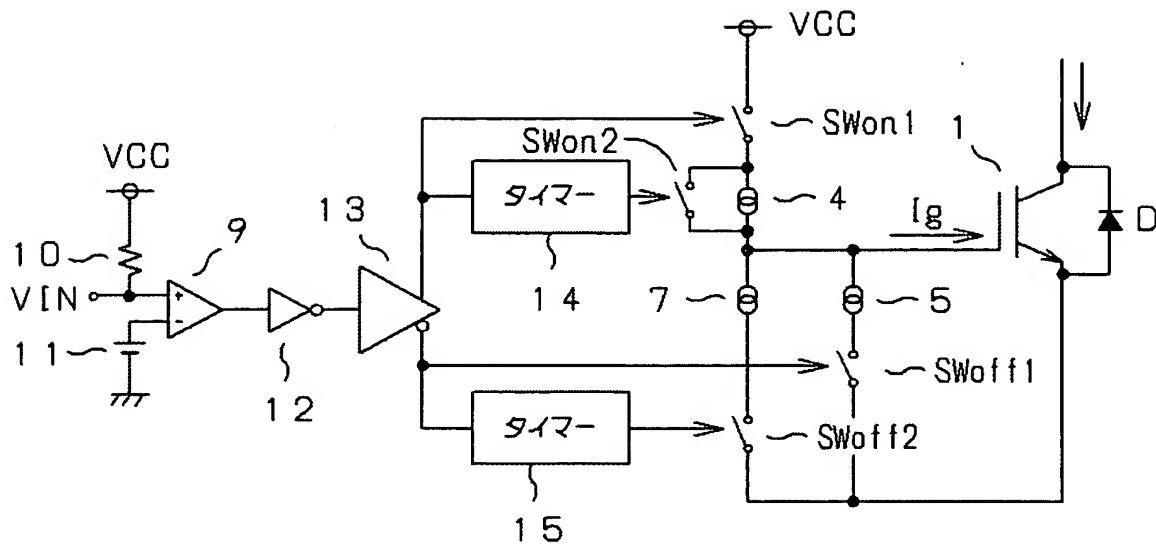
【符号の説明】

【0038】

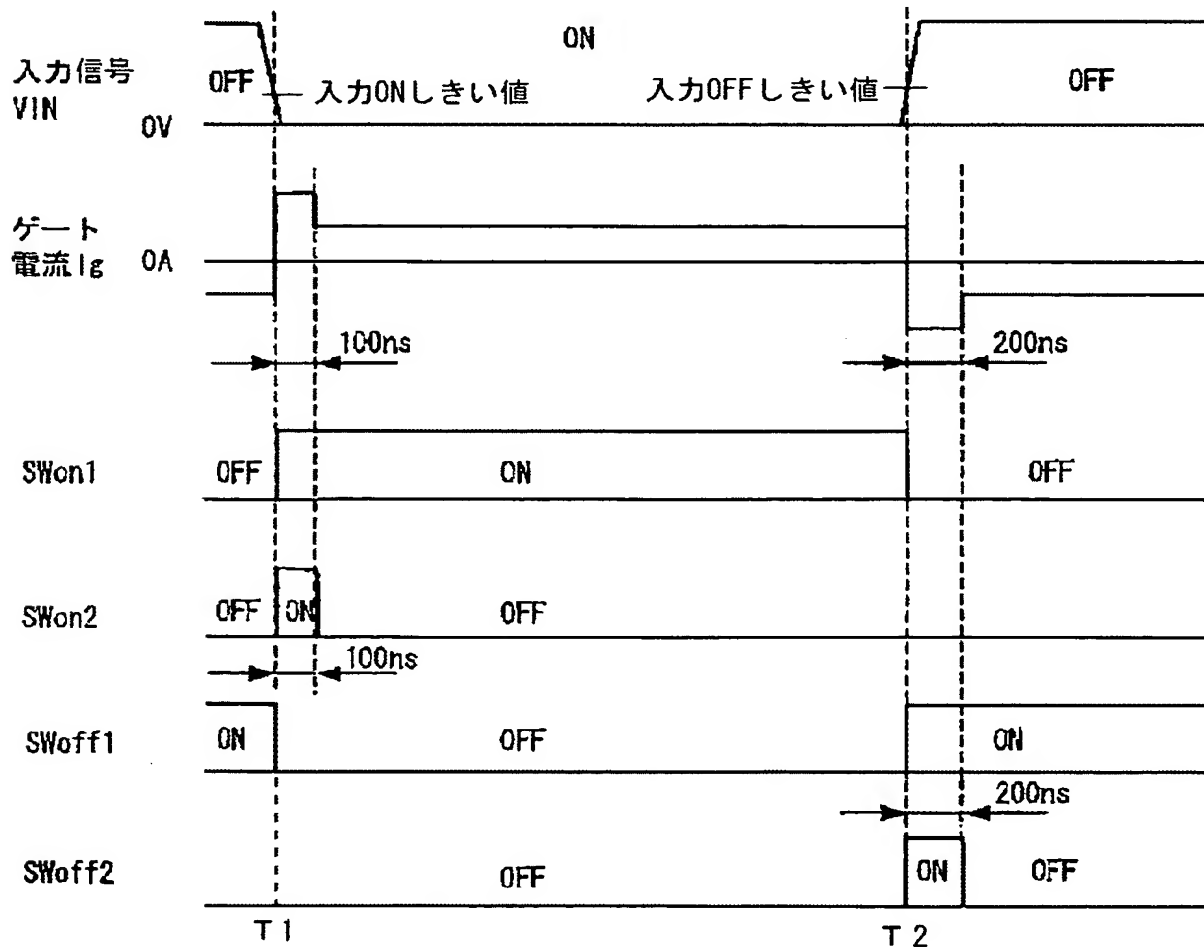
1 IGBT、5 定電流素子、9 コンパレータ、11 基準電圧源、12 インバータ、13 アンプ、14 タイマー、15 タイマー、22 タイマー、24 コンパレータ、25 基準電圧源、26 ラッチ回路、27 ラッチ回路、28 インバータ、29 アンドゲート、SW スイッチ、D フリーホイールダイオード

【書類名】 図面

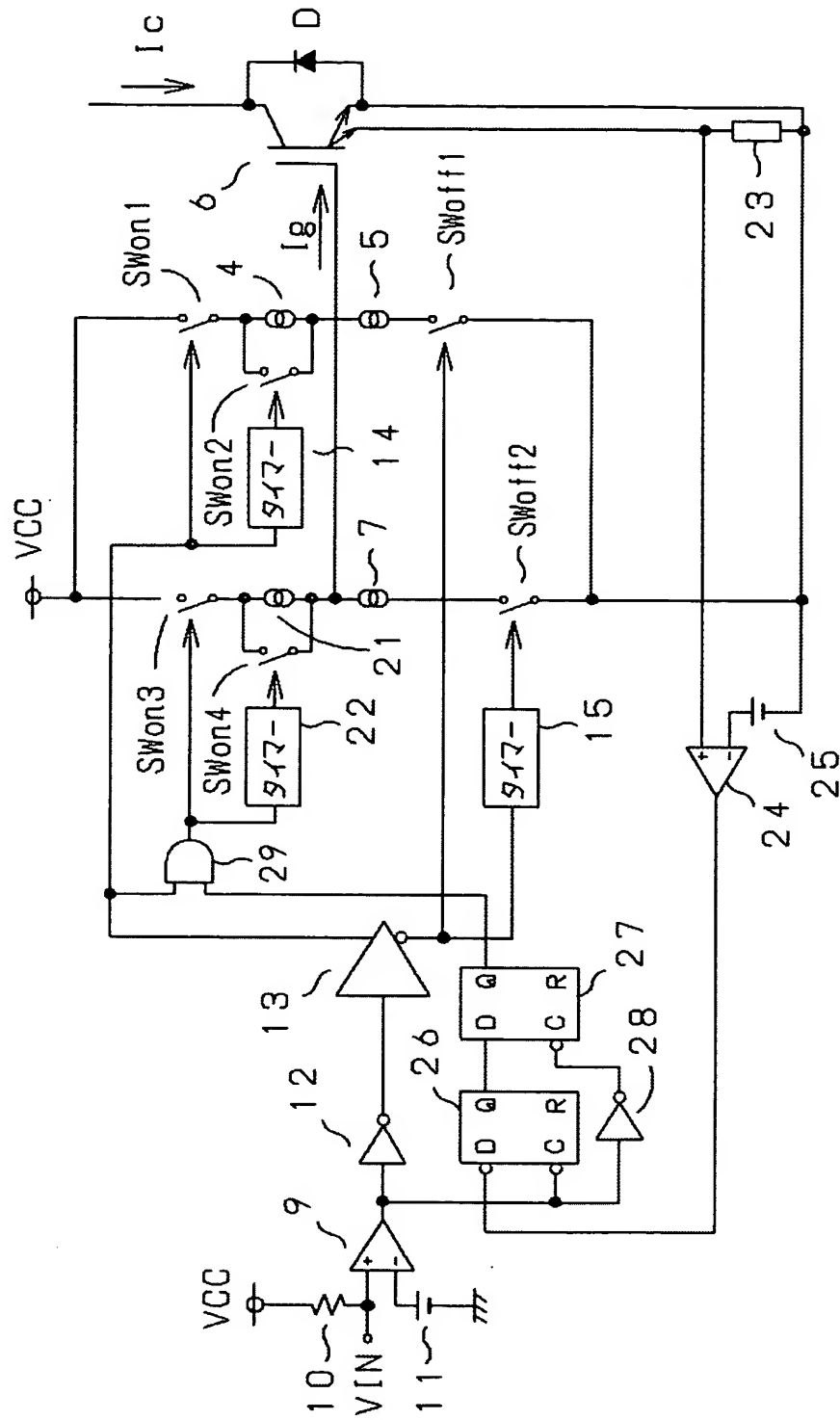
【図 1】



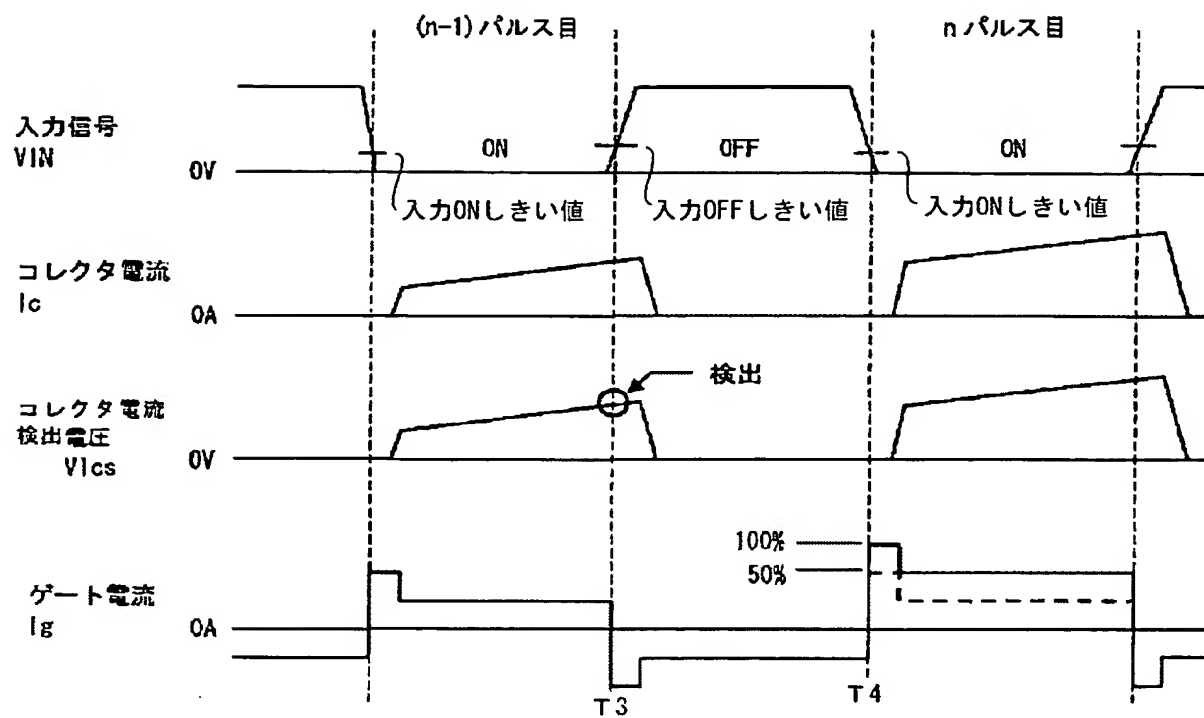
【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ゲート抵抗を通じてゲートをオンオフするものでは、ターンオンまでの遅延時間が長くなる。

【解決手段】 IGBT1のゲートオン時にスイッチSWon1をオンにしてゲート電流を供給し、ゲートオフ時にスイッチSWoff1をオンにしてゲート容量の電荷を放電する半導体装置において、前記ゲート電流を増大させるためにスイッチSWon2を備え、前記スイッチSWon1のオン時に、前記スイッチSWon2を第1の所定の時間だけオンにするタイマー14を備える。そして、前記放電時の放電電流を増大させるためにスイッチSWoff2を備え、前記のスイッチSWoff1のオン時に、前記スイッチSWoff2を第2の所定の時間だけオンにするタイマー15を備える。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 3 - 2 7 8 2 2 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 0 1 3]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 3 号

氏 名

三菱電機株式会社